



中华人民共和国国家标准

GB/T 15651.7—2024

半导体器件 第5-7部分:光电子器件 光电二极管和光电晶体管

Semiconductor devices—Part 5-7: Optoelectronic devices—
Photodiodes and phototransistors

(IEC 60747-5-7:2016, MOD)

2024-03-15 发布

2024-07-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	III
引言	IV
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 光电二极管的基本额定值和特性	9
5 光电晶体管的基本额定值和特性	10
6 光敏器件的测试方法	12
参考文献	16

前　　言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 GB/T 15651 的第 5-7 部分，GB/T 15651 已经发布了以下部分：

- 半导体器件 分立器件和集成电路 第 5 部分：光电子器件(GB/T 15651—1995)；
- 半导体分立器件和集成电路 第 5-2 部分：光电子器件 基本额定值和特性(GB/T 15651.2—2003)；
- 半导体分立器件和集成电路 第 5-3 部分：光电子器件 测试方法(GB/T 15651.3—2003)；
- 半导体器件 分立器件 第 5-4 部分：光电子器件 半导体激光器(GB/T 15651.4—2017)；
- 半导体器件 第 5-5 部分：光电子器件 光电耦合器(GB/T 15651.5—2024)；
- 半导体器件 第 5-6 部分：光电子器件 发光二极管(GB/T 15651.6—2023)；
- 半导体器件 第 5-7 部分：光电子器件 光电二极管和光电晶体管(GB/T 15651.7—2024)。

本文件修改采用 IEC 60747-5-7:2016《半导体器件 第 5-7 部分：光电子器件 光电二极管和光电晶体管》。

本文件将国际文件的第 4 章～第 7 章调整到第 3 章，符合我国标准的要求，便于标准的使用，之后的章条号顺延。

本文件做了下列最小限度的编辑性改动：

- a) 删除了资料性附录 A，与本文件内容无关；
- b) 将“3.2 光学辐射 波长位于向 X 射线过渡区($\lambda \approx 1 \text{ nm}$)和向无线电波过渡区($\lambda \approx 1 \text{ mm}$)之间的电磁辐射”第二个($\lambda \approx 1 \text{ nm}$)改为($\lambda \approx 1 \text{ mm}$)，改正其中的编辑性错误。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出并归口。

本文件起草单位：中国电子技术标准化研究院、厦门市产品质量监督检验院、惠州仲恺高新区 LED 品牌发展促进会、浙江智菱科技有限公司、中国电子科技集团公司第十三研究所、厦门华联电子股份有限公司、中国光学光电子行业协会、四川华体照明科技股份有限公司、北京大学东莞光电研究院。

本文件主要起草人：刘秀娟、葛莉荭、成森继、李俊凯、刘东月、郑智斌、洪震、段琼、李俊、李成明。

引　　言

制定 GB/T 15651 系列的第 5-7 部分,为一般工业应用的光电二极管和光电晶体管产品的测试、评价等提供适当的依据。

GB/T 15651 是半导体光电子器件的系列标准,主要规定了光电子器件的总体要求、基本额定值和特性、测试方法、半导体激光器、光电耦合器、发光二极管、光电二极管和光电晶体管等器件的技术要求、质量保证规定等内容,拟由以下几个部分构成。

- 第 5 部分:光电子器件。目的在于给出半导体光电子发射器件、半导体光敏元器件、内部工作机理与光辐射有关的半导体器件和分类型器件的标准。
- 第 5-2 部分:光电子器件 基本额定值和特性。目的在于给出半导体光电子发射器件、半导体光电探测器件、半导体光敏器件、内部进行光辐射工作的半导体器件及分类为光电子器件的基本额定值和特性,用于光纤系统或子系统的除外。
- 第 5-3 部分:光电子器件 测试方法。目的在于给出光电子器件的测试方法,用于光纤系统或子系统的除外。
- 第 5-4 部分:光电子器件 半导体激光器。目的在于给出半导体激光器的基本额定值、特性和测试方法。
- 第 5-5 部分:光电子器件 光电耦合器。目的在于给出光电耦合器的术语、基本额定值、特性、安全试验及测量方法。
- 第 5-6 部分:光电子器件 发光二极管。目的在于给出发光二极管的术语、额定值和特性、测试方法和质量评估方法。
- 第 5-7 部分:光电子器件 光电二极管和光电晶体管。目的在于给出光电二极管和光电晶体管的术语、基本额定值和特性以及测量方法。

半导体器件 第5-7部分:光电子器件

光电二极管和光电晶体管

1 范围

本文件规定了光电二极管(以下简称“PDs”)和光电晶体管(以下简称“PTs”)的术语、基本额定值和特性以及测试方法。

本文件适用于光电二极管和光电晶体管。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 物理概念

3.1.1

电磁辐射 electromagnetic radiation

辐射 radiation

- a) 能量以与光子有关联的电磁波的形式发射或传播。
- b) 电磁波或光子。

[来源:GB/T 2900.65—2004,845-01-01,有修改]

3.1.2

光学辐射 optical radiation

波长位于向X射线过渡区($\lambda \approx 1 \text{ nm}$)和向无线电波过渡区($\lambda \approx 1 \text{ mm}$)之间的电磁辐射。

[来源:GB/T 2900.65—2004,845-01-02]

3.1.3

可见辐射 visible radiation

任何能够直接引起视觉的光学辐射。

注: 可见辐射的光谱范围没有明确的界限,因为它取决于到达视网膜的辐射功率和观察者的响应度。下限一般在360 nm 和 400 nm 之间,上限在 760 nm 和 830 nm 之间。

[来源:GB/T 2900.65—2004,845-01-03]

3.1.4

红外辐射 infrared radiation

波长大于可见辐射波长的光学辐射。

[来源: GB/T 2900.65—2004, 845-01-04,有修改]